

2SK2384

NチャネルMOS形シリコン電界効果トランジスタ
超高速スイッチング用

- 特長
- ・低オン抵抗。
 - ・超高速スイッチング。
 - ・4V駆動。

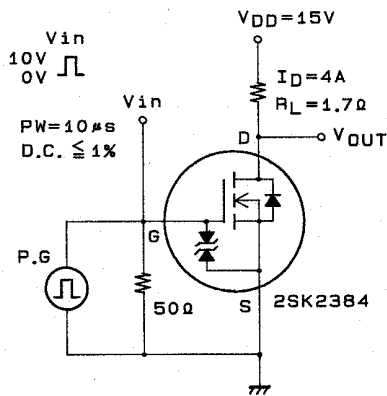
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta = 25°C

			unit
ドレイン・ソース電圧	V _{DSS}	30	V
ゲート・ソース電圧	V _{GSS}	±15	V
ドレイン電流 (DC)	I _D	6	A
ドレイン電流 (パルス)	I _{DP}	PW ≤ 10μs, duty cycle ≤ 1%	48 A
許容損失	P _D	セラミック基板 (1200mm ² × 0.8mm) 装着時	2.0 W
チャネル温度	T _{ch}		150 °C
保存周囲温度	T _{stg}		-55 ~ +150 °C

電気的特性 Electrical Characteristics / Ta = 25°C

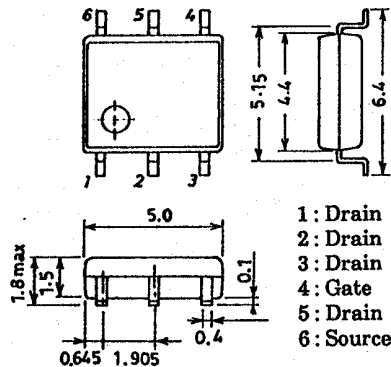
			min	typ	max	unit
ドレイン・ソース降伏電圧	V _{(BR)DSS}	I _D = 1mA, V _{GS} = 0	30			V
ドレイン・ソースシャ断電流	I _{DSS}	V _{DS} = 30V, V _{GS} = 0			100	μA
ゲート・ソースもれ電流	I _{GSS}	V _{GS} = ±12V, V _{DS} = 0			±10	μA
ゲート・ソースシャ断電圧	V _{GS(off)}	V _{DS} = 10V, I _D = 1mA	1.0		2.0	V
順伝達アドミタンス	Y _{fs}	V _{DS} = 10V, I _D = 4A	5	8		S
ドレイン・ソース間オン抵抗	R _{DS(on)1}	I _D = 4A, V _{GS} = 10V	24	35	50	mΩ
	R _{DS(on)2}	I _D = 4A, V _{GS} = 4V		50	70	mΩ
入力容量	C _{iss}	V _{DS} = 10V, f = 1MHz		1000		pF
出力容量	C _{oss}	V _{DS} = 10V, f = 1MHz		550		pF
帰還容量	C _{rss}	V _{DS} = 10V, f = 1MHz		180		pF
ターンオン遅延時間	t _{d(on)}	下図指定回路において		13		ns
立ち上がり時間	t _r	〃		40		ns
ターンオフ遅延時間	t _{d(off)}	〃		130		ns
下降時間	t _f	〃		120		ns
ダイオード順電圧	V _{SD}	I _S = 8A, V _{GS} = 0	1.0	1.2		V
ドレイン電流	I _{DSX}	V _{DS} = 5V, V _{GS} = 0.1V			0.5	μA

スイッチングタイム測定回路



A03515

外形図 2113
(unit: mm)



SANYO: MFP6

※これらの仕様は、改良などのため変更することがあります。